PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-211835

(43)Date of publication of application: 19.09.1986

(51)Int.CI.

G11B 7/00 GO2F 1/17

1/733 GO3C

GO3C 5/00 G11B 7/24

(21)Application number: 60-053117

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

15.03.1985

(72)Inventor:

YOSHTIKE NOBUYUKI

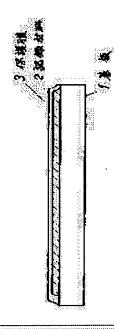
KONDO SHIGEO

(54) OPTICAL RECORDING METHOD

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the storage density of information by changing the light intensity or the light irradiation time in the stage of irradiating the light thereby controlling the change quantity of the light absorption band to several stages in the stage of using a material the light absorption band of which changes when irradiated with the light as a recording material and subjecting the material to optical recording.

CONSTITUTION: A tungsten oxide layer 2 as the recording material is deposited by a vapor deposition method to 6000 & angst; on, for example, a glass substrate 1 (may be plastic, metal or ceramics) and further an SiOx film 3 is laminated as a protective film to 3000 & angst; thereon by which the recording material is formed. The color change density of the recording material can be stepwise controlled according to the stepwise irradiation when the irradiation light energy is stepwise irradiated to such recording material. The light irradiation energy is proportional to the intensity and time of the irradiation light and therefore the control of the irradiation energy is made possible by changing the intensity of the irradiation light or the irradiation time.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-211835

௵Int_Cl_⁴		識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和61年(198	6)9月19日
G 11 B G 02 F	7/00 1/17		A - 7734 - 5D 7204 - 2H					
G · 03 C	1/733 5/00		8205-2H 8205-2H		1. 7.4. 15			
G 11 B	7/24		A - 8421 - 5D	審査請求	未請求	発明の数	1	(全4頁)

の発明の名称 光記録方法

②特 願 昭60-53117

20出 願 昭60(1985)3月15日

②発明者 告池 信幸 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内②発明者 近藤 繁雄 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地

码代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明細 化自

発明の名称
 光記録方法

2、特許請求の範囲

- (1) フォトクロミック材料に照射する照射光の強度もしくは照射回数を変化させて異なる任意の段階の発色機度状態に記録することを特徴とする光記録方法。
- (2) フォトクロミック材料が、酸化タングステンもしくは酸化モリプデンの少なくとも一種である ことを特徴とする特許請求の範囲第1項配載の光 記録方法。
- (3) 光記録信号に一定の規準発色濃度を与える信号を任意の間隔で含ませたことを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の光記録方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は音声、画像、電気信号を記憶、再生、消去するための記録方法に関する。

従来の技術

音声,画像,電気信号を記憶,再生,消去する ために従来から磁気および光記憶方式がとられて いる。光記億方式のものは磁気記憶方式に較べて 記憶密度が高く出来るととから注目されて来てい る。光記憶方式のものは、アクリル基板上に形成 されたTeC記録膜等に信号に応じてレーザー光を 照射して熱モードで記録膜に孔をあけることによ り情報を記録するものと、記録膜としてTeOູ膜 等を用いてレーザー光照射により熱モードで晶質 - 非晶質の変化を行なわせ光反射率の異なる状態 を作る方式が一般的である。又、配録膜としてホ トクロミズムを有する膜を用いて光照射により発 色させ、光の吸収率の異なる状態を作る方式が提 唱されている。 従来、これらの記録材料を用いた 記録方式は、孔があるか否か、晶質一非晶質,無 色-発色等の状態変化を"O"-"1"の信号とし て記憶するものである。

すなわち一つの記録部には"○"もしくは"1" の2つまでの情報しか記憶できないものであり情報の記憶密度が限定されるものである。 発明が解決しようとする問題点

本発明は、記録材料の一つの記録部に"〇"も しくは"1"の信号以上の情報を配憶させ記憶密 度の高い記録方式を提供する。

問題点を解決するための手段

記録材料として光照射により材料の光吸収帯が 変化する材料を用いて、該材料に光配録する際、 光照射時の光強度もしくは、光照射時間を変えて 光吸収帯の変化量を数段階に行う。

本発明により、一つの記録部に"O"もしくは "1"の信号ではなくたとえば "O", "1", "2" ~"4"の5段階の信号を記憶することにより情 報の記憶密度を飛躍的に向上できる。

実 施 例

光照射により色変化をする材料は、一般に照射 する光のエネルギーに比例して色変化を生じるo ただし、光のエネルギーが照射部の全材料が色変 化を達成するより高いエネルギーが照射された場 合飽和状態となる。第1図に照射エネルギーと色

6 ...

着法により記録材料として酸化タングステン層 (WO₂) 2 を 6 O O O A 蒸 着 した。 さらに 保護膜 としてSiOェ膜3を3000A積層することによ り記録材料を作成した。

蒸着された試料にHe-Cd レーザ()=325 nm)を用いて一定時間不活性ガス雰囲気中で光 照射を行なったととろ光照射部が背色に発色した。 発色濃度をHe-Ne レーザ () = 6328 nm)を 用いて測定した結果を表に示す。

ロットル	光照射時間	発色濃度(4OD)
1	10 msec	0.03
2	50 msec	0.12
э	100 msec	0.22
4	200 msec	0.45

表より、光照射時間の異なる状態すなわち光照 射エネルギーの異なる状態に対応して発色濃度を 4段階に変化させ記録できることが判った。光照 射時間の制御は、実際的には、同一記録部に照射 変化濃度(光学密度 40D)との関係を模式的に 示す。この様な記録材料を用いて、今、照射光エ ネルギーを段階的に第1図のOからAまでのエネ ルギーをそれぞれ照射した場合、それに応じて配 録材料の色変化濃度も、段階的に制御することが できる。第2図イ,ロは各々パルス的に各エネル ギーを照射した場合の照射エネルギーと色変化機 度(4OD)を図示する。·

以上の記録方式により、一つの記録部に、例え ば第2図イ、ロに示すよりに5段階の異なる状態 を形成するととができ、情報の記録密度を従来の 2.5倍(従来は、0と1のみ)に上げることがで きる。

尚、光照射エネルギーは、照射光の強度と時間 に比例することから、照射エネルギーの制御は、 照射光の強度もしくは照射時間を変化させること によって達成できる。

<與施例1>

第3図に示すごとくガラス基板1(プラスチッ ク、金属もしくはセラミックスでもよい)上に蒸

6 K-1

する照射光パルスの照射回数で行なえる。 く 実施 例 2 >

実施例と同様にMoO3膜を用いた記録材料を作 成し、照射強度の異なる He – Cd レーザ(ス = 3 2 5 nm)を用いてそれぞれ200msec 光書 き込みを行なった。照射光強度はNDF (Newtral Density Filter)を用いて4段階に減衰させ た。 光照射部の WO₃ 膜が育色に発色し、照射光 強度に対応して4段階の発色機度変化が得られた。

光記録時に、照射エネルギー差により効率よく 発色濃度を制御できる記録材料を検討した結果、 次のものが可能である。

(1) **避移金属酸化物……WO**3, MoO3, TiO2,

V₂O₅, Cr₂O₃, Nb208

(2)

金属錯体 …… 芳香族ジアミン系金属錯

錯体, 芳香族 ジチオール 系金属錯体,メルカブト

フェニルアミン系金属錯

体,脂肪族ジチオール系

7 ..

金属錯体 , アニールアル ミニウム塩

(3) 有機化合物…… シアニン色素,ナフトキ ノン色素,スクアリリウ ム色素,テトラデヒドロ コリン,メチン染料,ピ リリウム染料,ポリピロ ール,(SN)_x ポリマー, テトラヘテロフルパレン

(4) 金属塩 …… ハロゲン化銀 , Cu(NO₃)₂, CuSO₄ 敬粒子

(6) かログン化合物 …… As-Ge-Te, Te-Ge
-Sb-S, As-Se-S-Ge,
As-S, As-S-Te等に、
Ag, Cuをドーピングした

尚、発色層の膜厚は厚い程<u>数千人から</u> ちれるものであり、膜厚としては数万人が好ましい。 本実施例においては光書き込み光源として He-Cd レーザを用いたが N₂ レーザ、Arレーザ、Xe

ネルギーの強弱によって光反射率、もしくは光透過率が段階的に変化しりる記録材料であれば、同じ記録方式により高密度化が可能であり、特に記録材料に限定をうけるものではない。

発明の効果

以上のように本発明による記録方式を用いることにより、従来と同様の記録材料を使用するにもかいわらず、記録密度を飛躍的に向上することが できる。

4、図面の簡単な説明

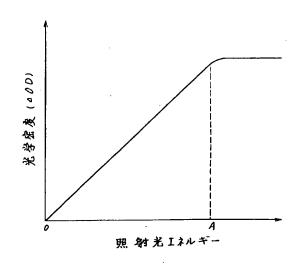
第1図は照射光エネルギーと記録材料の光学密度変化の相関関係を表わす図、第2図は記録方式を説明するための模式図、第3図は基本的な記録材料の断面図、第4図は発色部の高温保存における劣化特性図である。

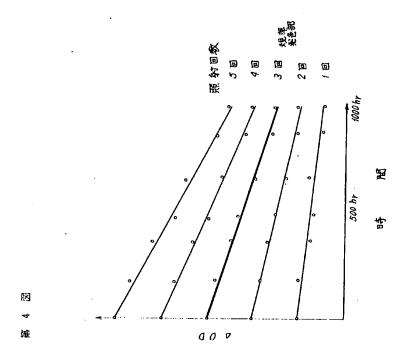
1 ·····・ 基板、2 ·····・ 記録材料、3 ······保 と 膜。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名 光顔,Hg光源等、放長が、440 nm より短かい 光であれば利用できる。

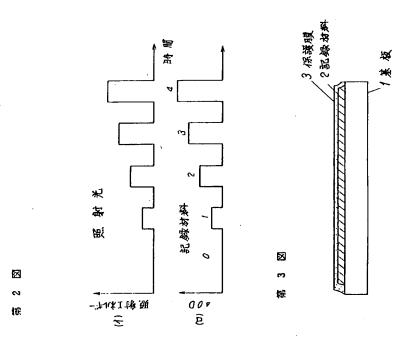
<実施例3>

尚、前記実施例においては光照射により光吸収 帯が変化する材料について記述したが、光照射エ

第 1 図







BEST AVAILABLE COPY